磁控溅射方法制备垂直取向 FePt/BN 颗粒膜*

李宝河¹²) 冯 春¹) 杨 涛¹) 翟中海¹³) 滕 蛟¹) 于广华¹) 朱逢吾¹)

1)(北京科技大学材料物理系,北京 100083)

2)(北京工商大学数理部,北京 100037)

3)(沈阳建筑大学理学院,沈阳 110168)

(2005年10月25日收到;2005年11月22日收到修改稿)

用磁控溅射在热单晶 MgC(100)基片上制备了[FePt/BN]多层膜 经真空热处理后,得到具有垂直取向 L1₀-FePt/ BN 颗粒膜.X 射线衍射结果和磁性测量的结果表明 [FePt(2nm)/BN(0.5nm)]₀和[FePt(1nm)/BN(0.25nm)]₀多层 膜经 700℃热处理 1h 后 均具有较好的(001)取向.[FePt(1nm)/BN(0.25nm)]₀垂直矫顽力达到 522kA/m 剩磁比达到 0.99 开关场分布 S*达到 0.94 FePt 晶粒平均尺寸约 15—20nm ,适合用于将来超高密度的垂直磁记录介质.

关键词:磁控溅射,垂直磁记录,L1₀-FePt/BN 纳米颗粒膜 PACC:7550S,7570F

1.引 言

有序的 Ll_o-FePt 合金薄膜具有非常高的磁晶各 向异性能 7 × 10⁶ J/cm³),在超高密度磁记录情况下 仍具有非常好的热稳定性1-31 垂直磁记录方式可 以比目前普遍采用的纵向磁记录方式记录密度提高 一个数量级 但垂直磁记录介质需要具备垂直膜面 的磁易轴取向,因此研究有序的Ll₀-FePt 合金薄膜 的垂直取向成为近年来一个热点^[4]利用非磁性的 金属或氧化物为母体 Ag^[5],Al₂O₃^[6],BN^[7],C^[8]等, 形成 FePt 颗粒膜,可以降低或消除颗粒间的磁耦合 作用.其中,Daniil 等人报道了在 Si 基片上生长的 FePt/BN 多层膜,经 600℃或 700℃退火,获得 FePt-BN 颗粒膜,电镜研究结果表明,FePt 颗粒在 5-10nm 且颗粒大小非常均匀,所以 BN 是一种形成 FePt 颗粒膜的优秀的基体材料^[7]. 但是 Daniil 等人 制备的 FePt-BN 颗粒膜不具备垂直取向,不能适用 于垂直磁记录介质的需要。

利用多层膜的界面各向异性可以诱导垂直各向 异性的产生,如在玻璃基片上非外延生长 FePt/B₂O₃ 多层膜^[9,10].另外利用磁控溅射 CrRu^[11]或 MgO^[12,13] 为底层也可实现 FePt(001)织构.我们研究了在热 MgO 单晶基片上生长的 FePt/Ag 纳米复合膜,获得 了很好的垂直取向^[14,15].利用相似的方法,我们制备 了 FePt/BN 纳米复合薄膜.

本文研究利用磁控溅射,采用两步加热处理,即 在 250℃,MgQ(001)单晶基片上首先沉积 FePt/BN 多 层膜,后经高温真空热处理,获得了高矫顽力、垂直 取向纳米复合薄膜.氮化物为基体的 FePt 纳米复合 膜的垂直取向尚未见报道.

2. 实验方法

采用磁控溅射方法制备(FePt/BN), 多层膜.采 用直流共溅射方法,通过改变 Fe 靶(99.95%)和 Pt 靶(99.95%)共溅射时各自的功率,来调节 Fe,Pt 共 溅射的成分,实现 Fe₅₂Pt₄₈的相对成分. Fe 靶和 Pt 靶 采用直流共溅射,BN 靶(99.95%)采用射频溅射,在 MgQ(100)单晶基片上交替沉积 FePt 和 BN 层,制备 了(FePt/BN), 多层膜.溅射时基片保持 250°C,溅射 前本底真空优于 4×10^{-5} Pa,溅射时 Ar 工作气压为 0.4Pa.Fe 靶和 Pt 靶共溅射时薄膜总的沉积速率为 0.16nm/s,BN 的沉积速率为 0.070nm/s.溅射时基片 以 18r/min 的速率旋转.

直接溅射的[FePt/BN] 多层膜经过 600℃或

^{*}国家自然科学基金(批准号 50571007)和北京市教育委员会科技发展计划项目(批准号:KM200610011005)资助的课题。

700℃真空热处理 1h,热处理时真空优于 5×10⁻⁵ Pa.

利用 X 射线衍射(XRD)分析样品的晶体结构 (Cu Kα),用等离子体感应原子发射光谱(ICP-AES) 分析样品成分.利用交变梯度场磁强计(AGM)测量 样品的磁性.薄膜沉积速率由台阶仪测厚度来确定.

3. 结果与讨论

图 1 是基片保持 250℃,溅射沉积的[FePt (2nm)/BN(dnm)]₀(d=135)多层膜,经600℃热 处理 1h 后的 XRD 谱. 可以看出,所有样品的 XRD 谱都只出现了 FePt 的(001)(002)衍射峰,但峰比较 宽化,说明 FePt 晶粒非常细小.未发现 FePt 的(111) 峰和(110)峰表现出较强的(001)织构.图1中的小 插图为各样品的小角 XRD 谱,结果表明虽然经过 600℃真空热处理 1h.但样品仍存在多层膜的结构 周期性,说明 BN 的层状结构仍存在 因此在 FePt 薄 膜在(001)方向的相干长度应该很小.小角衍射峰上 的数字表示衍射级次(k 值),由于测量设备的限制, 我们只能测量衍射角 20 大于 2°的衍射谱线 因此对 于[FePt(2nm)BN(3nm)]₀和[FePt(2nm)BN (5nm)]。观察不到1级小角衍射峰.由小角衍射峰 计算多层膜的周期,均和设计值比较接近.由大角 XRD 谱的(001)和(002)衍射峰的半高宽计算晶粒平 均尺寸为 2.9—3.7nm. 这说明了在垂直膜面方向晶 粒的生长受到界面的抑制,

在最大外加磁场 1432kA/m 下,利用 AGM 测量 了样品垂直膜面方向的磁滞(*M-H*)回线.图 2 给出 了在 MgO(100)250℃ 恒温基片上溅射的 [FePt (2nm)/BN(d nm)]₀(d = 1,3,5)多层膜经 600℃热 处理 1h 后的磁滞回线(*M-H* 回线).可以看出,所有 样品磁滞很小,矫顽力很低.这主要是因为晶粒太小 的缘故.L1₀-FePt 的超顺磁临界尺寸为 2.8nn^[1].由 图 1 样品的 XRD 谱计算的晶粒平均尺寸为 2.9— 3.7nm,接近 L1₀-FePt 的超顺磁临界尺寸.

为了进一步使 FePt 和 BN 互扩散更加充分,将 直接溅射的 FePt/BN 多层膜在 700℃热处理 1h, [FePt(2nm)/BN(d nm)]₀(d = 0.5,1,3)多层膜的 XRD 谱如图 3 所示.[FePt(2nm)/BN(0.5nm)]₀多层 膜和 FePt(2nm)/BN(1nm)]₀多层膜经 700℃热处理 1h 后 衍射峰只有 L1₀-FePt 的(001)(002)(200), (003)峰和 MgO 的(200)峰,未发现 FePt 的(111)峰,



图 1 [FeP(2nm)BN(d nm)]₀(d = 1,3,5)多层膜,经 600℃热 处理 1h 后的 XRD 谱

而且(200)峰与(002)峰相比非常弱.表现出很强的 (001)垂直取向.随着 BN 的加厚,出现了 FePt 的 (111)峰.

图 3 中的小插图为各样品的小角 XRD 谱,由图 可见,小角峰全部消失,表明经过 700℃真空热处理 1h后,多层膜结构消失,形成了 FePt 颗粒埋在 BN 母体中的颗粒膜.利用谢乐公式,根据大角衍射峰 (001)和(002)的半高宽计算晶粒平均尺寸约 为15—20nm.

图 4 为 [FeP(2nm)/BN(d nm)]₀(d = 0.5, 1, 5) 多层膜 经 700℃热处理 1h 后的磁滞回线.测量时外 场垂直于膜面.由于受到 AGM 所能加的最大外场 (1.4×10⁶ A/m)的限制,部分样品的磁化并没有达到 饱和.可以看出,随着 BN 厚度的增加,磁易轴垂直 膜面取向的性能变差,BN 厚度为 0.5nm 和 1nm 时, 具有很好的垂直磁各向异性.且垂直磁滞回线的矩 形度 很好,具有 很好的开关场特性.对于[FePt (2nm)/BN(0.5nm)]₀多层膜经 700℃热处理 1h 后, 样品的具体磁性参数为:垂直矫顽力达到 595kA/m, 剩磁比达到 0.93,矫顽力矩形比(开关场分布) $S^* = 0.87$.

增加单位体积薄膜内的界面数可以通过改变多 层膜中磁性层的厚度实现,在相同的条件下,制备了 [FePt(1nm)/BN(d nm)]₀(d=0.25,0.5,1)多层膜, 后经 700℃热处理 1h.样品的 XRD 谱如图 5 所示.



图 2 [FeP(2nm)BN(d nm)]₀(d = 1,3,5)多层膜,经 600℃热 处理 1h后的磁滞回线



图 3 [FeP(2nm)BN(d nm)]₀(d = 0.5 ,1 3 5)多层膜 经 700℃ 热处理 1h 后的 XRD 谱

[FeP(1nm)/BN(0.25nm)]₀多层膜和[FeP(1nm)/BN (0.5nm)]₀多层膜经 700℃热处理 1h 后,出现了很 强的 FePt 的(001)和(002)峰,FePt(200)峰相对很 弱,而且未出现 FeP(111)峰,样品基本表现为(001) 织构.[FePt(1nm)/BN(1nm)]₀多层膜经 700℃热处



图 4 [FeP(2nm)/BN(dnm)]₀(d=0.5,15)多层膜 经 700℃热 处理 1h 后的磁滞回线(测量时外磁场垂直于膜面)

理 1h 后,由 XRD 可以发现出现了 FePt(111)峰,未显示较好的(001)取向.随着 BN 厚度的增加,FePt 的(001)和(002)衍射峰逐渐宽化,说明 FePt 的晶粒 随 BN 厚度增加而减小.这些结果与图 3 类似.



图 5 [FePt(1nm)/BN(d nm)]₀(d = 0.25,0.5,1)多层膜,经 700℃热处理 1h后的 XRD 谱

图 6 为[FeP(1nm)BN(*d* nm)],(*d* = 0.25 0.5, 1)多层膜 经 700℃热处理 1h 后的磁滞回线.对于 *d* = 0.25nm 情况,垂直膜面的磁滞回线具有很好的矩 形度和很好的开关场特性,根据[FePt(1nm)BN (0.25nm)]₀薄膜的垂直磁滞回线计算:垂直矫顽力 达到 522kA/m,剩磁比达到 0.99,矫顽力矩形比 S* = 0.94.

比较图 4 和图 6,可以发现 FePt/BN 多层膜中 FePt 和 BN 厚度比接近的样品具有完全类似的磁滞 回线.例如 FePt 和 BN 厚度比为 2 或 4 的样品都具 有很好的垂直磁各向异性,垂直膜面的磁滞回线具 有很好的矩形度且剩磁比接近 1.而 FePt/BN 多层膜 中 FePt 和 BN 厚度比大于 1 时,垂直膜面磁滞回线





很倾斜,矫顽力矩形比很低,样品磁化易轴既不在面 内也不在垂直膜面方向.[FeP(1nm)/BN(0.25nm)]。 多层膜经 700℃热处理 1h 后比[FePt(2nm)/BN (0.5nm)]。多层膜经相同条件热处理,具有更好的 矩形度和矫顽力矩形比.

FePt/BN 多层膜经高温真空退火,可以获得较好的 L1₀-FeP(001)取向外延生长,主要是由于两方面的因素:一方面,FePt 薄层(<5nm)厚度时,在热MgC(00)单晶基片上溅射可以实现外延生长;另一方面,利用 FePt/BN 多层膜的界面效应,促进 FePt 薄膜垂直取向生长.这与我们以前报道的 FePt/Ag 复合薄膜垂直取向生长的原因是类似的^[5].但由于 BN 为非金属化合物,且具有复杂的晶体结构,而 Ag 为金属,且与 L1₀-FePt 具有类似的晶体结构,当 BN 浓度较大时,反而阻碍了 FePt 在热 MgO(00)单晶基片上的外延生长,因此 BN 厚度较大时,FePt/BN 没有获得很好的垂直取向.这与 FePt/Ag 复合薄膜的结果不同 [FePt(2nm)/Ag(11nm)]仍具有很好的垂直 各向异性^[5].

4.结 论

利用磁控溅射在热 MgO 基片(250 °C)上制备的 [FePt/BN] 多层膜 ,X 射线衍射和磁性测量的结果表 明 [FePt(2nm)/BN(0.5nm)]₀ 和[FePt(1nm)/BN (0.25nm)]₀多层膜经 700 °C 热处理 1 h 后 ,均具有 较好的(001)取向.典型的结果是:[FePt(1nm)/BN (0.25nm)]₀垂直矫顽力达到 522kA/m ,剩磁比达到 0.99 ,开关场分布 S^{*}达到 0.94 ,适合于未来高密度 垂直磁记录介质的需要.

- [1] Weller D , Moser A , Folks L , Best M E , Lee W , Toney M F , Schwickert M , Thiele J U , Doerner M F 2000 IEEE Tran . Magn . 36 10
- [2] Li B H, Hwang P, Yang T, Zhai Z H, Zhu F W 2005 Acta Phys. Sin. 54 1836 (in Chinese)[李宝河、黄 阀、杨 涛、翟中海、 朱逢吾 2005 物理学报 54 1836]
- [3] Li B H, Hwang P, Yang T, Feng C, Teng J, Zhu F W 2005 Acta Metal. Sin. 41 659 (in Chinese)[李宝河、黄 阀、杨 涛、冯 春、滕 蛟、朱逢吾 2005 金属学报 41 659]
- [4] Shima T, Takanashi K, Takahashi Y K, Hono K 2002 Appl. Phys. Lett. 81 1050
- [5] Li B H, Hwang P, Yang T, Feng C, Zhai Z H, Zhu F W 2005
 Acta Phys. Sin. 54 3867 (in Chinese) [李宝河、黄 阀、杨
 涛、冯 春、翟中海、朱逢吾 2005 物理学报 54 3867]
- [6] Ping D H, Ohnuma M, Hono K, Watanabe M, Iwasa T, Masumoto T 2001 J. Appl. Phys. 90 4708
- [7] Daniil M, Farber P A, Okumura H, Hadjipanayis G C, Weller D 2002 J. Magn. Magn. Mater. 246 297

- [8] Christodoulides J A, Huang Y, Zhang Y, Hadjipanayis G C, Panagiotopoulos I, Niarchos D 2000 J. Appl. Phys. 87 6938
- [9] Luo C P , Liou S H , Gao L , Liu Y , Sellmyer D J 2000 Appl. Phys. Lett. 77 2225
- [10] Yan M L , Zeng H , Powers N , Sellmyer DJ 2002 J. Appl. Phys. 91 8471
- [11] Xu Y F , Chen J S , Wang J P 2002 Appl . Phys. Lett. 80 3325
- [12] Kang K , Zhang Z G , Papusoi C , Suzuki T 2004 Appl. Phys. Lett. 84 404
- [13] Jeong S, Mchenry M E, Laughlin D E 2001 IEEE Tran. Magn. 37 1309
- [14] Yang T, Kang K, Suzuki T 2002 J. Phys. D: Appl. Phys. 35 2897
- [15] Yang T , Ahmad E , Suzuki T 2002 J. Appl. Phys. 91 6860

The preparation of FePt/BN particle films with perpendicular texture by magnetron sputtering *

Li Bao-He¹⁽²⁾ Feng Chun¹) Yang Tao¹) Zhai Zhong-Hai¹⁽³⁾ Teng Jiao¹) Yu Guang-Hua¹) Zhu Feng-Wu¹)

1) Department of Material Physics and Chemistry, Beijing University of Science and Technology, Beijing 100083, China)

2 X Department of Mathmatics and Physics , Beijing Technology and Business University , Beijing 100037 , China)

3 X College of Science , Shenyang Jianzhu University , Shenyang 110168 , China)

(Received 25 October 2005; revised manuscript received 22 November 2005)

Abstract

[FePt/BN]_n multilayers were prepared on MgO (100) single crystal substrates at 250 °C with magnetron sputtering. The perpendicular texture of L1₀-FePt/BN particle films was formed after vacuum annealing. The results of X-ray diffraction and magnetic tests show that the [FePt(2nm)/BN(0.5nm)]₀ and [FePt(1nm)/BN(0.25nm)]₂₀ multilayers have excellent (001) texture when the films were sputtered on substrates at 250 °C after annealed at 700 °C for 1h. The mean size of L1₀-FePt particles is roughly 15—20nm and its perpendicular coercive force reaches 522 kA/m. Moreover, the M_r/M_s and switching filed distribution S^* reach 0.99 and 0.94, respectively. This particle film is a candidate for future perpendicular magnetic recording media with ultrahigh density.

Keywords : magnetron sputtering , perpendicular magnetic recording , $L1_0$ -FePt/BN nanoparticle films PACC : 7550S , 7570F

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 50571007), and the Development Foundation of Science and Technology of Education Committee of Beijing, China (Grant No. KM200610011005).